



Рис. 4. Зависимость величины порогового напряжения (V_{th}) транзистора от дозы имплантации азота (D_{N^+}) при прямом (F) и обратном (B) порядке БТО для контрольных (W/O) и имплантированных (N^+) образцов

Fig. 4. Dependence of the threshold voltage value (V_{th}) of transistor on the dose of nitrogen implantation (D_{N^+}) with the direct (F) and reverse (B) order of rapid thermal annealing for control (W/O) and implanted (N^+) samples